

Übungsblatt Nr. 5

Aufgabe 1) Generation und Rekombination

Gegeben ist ein mit $n_D = 5 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ dotierter Silizium-Halbleiter bei $T = 300 \text{ K}$ mit der Eigenleitungsträgerdichte $n_i = 1,5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$. Die Ladungsträgerbeweglichkeiten sind $\mu_n = 1200 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, $\mu_p = 600 \text{ cm}^2/\text{Vs}$. Durch Lichteinstrahlung werden räumlich homogen Trägerpaare erzeugt mit einer Generationsrate

$$g = \begin{cases} g_L / 3 & \text{für } t < 0 \\ g_L & \text{für } t > 0 \end{cases},$$

wobei $g_L = 1 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ sei. Der dominante Rekombinationsprozess sei spontane Rekombination. Im Falle von schwacher Injektion weisen die Minoritätsträger eine Lebensdauer von $\tau_{\text{min}} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$ auf.

- Stellen Sie die Differentialgleichung für den zeitlichen Verlauf der Überschusskonzentrationen n' und p' für den Fall auf, dass schwache Injektion vorliegt. Schätzen Sie ab, ob unter den gegebenen Beleuchtungsbedingungen die Annahme schwacher Injektion tatsächlich gerechtfertigt ist.
- Berechnen Sie die stationären Überschusskonzentrationen für die oben angegebene Beleuchtungsstärke für $t < 0$ und $t > 0$.
- Bei angelegter äußerer Spannung wird der Strom durch den Halbleiter gemessen. Handelt es sich bei diesem gemessenen Strom um einen Driftstrom, einen Diffusionsstrom oder eine Kombination aus beiden? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Was ist dann das Verhältnis aus Dunkelstrom ($g_L = 0$) und dem stationären Strom bei $g = g_L$?

Aufgabe 2) Diffusion im stationären Zustand

Eine p-dotierte GaAs-Probe ($n_A = 1 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$) wird von links mit Licht der Photonenenergie 2 eV und konstanter Intensität bestrahlt. Die Länge der Probe L sei wesentlich größer als die Diffusionslänge $L_n = 10 \text{ }\mu\text{m}$ der Minoritätsträger. Die Beweglichkeiten für Elektronen und Löcher betragen $\mu_n = 8000 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$, $\mu_p = 400 \text{ cm}^2/(\text{Vs})$. Die Minoritätsträgerlebensdauer beträgt $\tau_n = 5 \cdot 10^{-9} \text{ s}$.

- Schätzen Sie mit Hilfe des Absorptionskoeffizienten α von GaAs ab (siehe Vorlesungsfolie), ob starke oder schwache Absorption vorliegt.
- Durch die Bestrahlung werde am linken Rand ($x = 0$) eine lokale Minoritätsträgerüberschussdichte von $n_p'(0) = 1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ erzeugt. Berechnen und skizzieren Sie die stationären Überschussträgerdichten $n_p'(x)$.
- Welcher stationäre Majoritätsträgerüberschuss $p_p'(x)$ stellt sich ein? Begründen Sie Ihre Antwort vor dem Hintergrund dielektrischer Relaxationsprozesse.
- Berechnen Sie die Diffusionsströme von Minoritäts- und Majoritätsladungsträgern unter Annahme der in b) und c) erhaltenen Verteilungsprofile. Im stationären Zustand verschwindet der Gesamtstrom. Berechnen Sie den Feldstrom der Majoritätsträger unter der Annahme, dass der Feldstrom der Minoritätsträger vernachlässigbar ist.
- Berechnen Sie das elektrische Feld aus dem Feldstrom in der Probe und die zugehörige Raumladungsdichte ρ . Vergleichen Sie die Größe ρ/e mit den

WS 2013/2014
Ausgabe am: 29.11.2012

Übungen zur Vorlesung Halbleiterbauelemente (Prof. Koos)
Bearbeitung bis: 06.12.2013

Überschussdichten der Minoritäts- bzw. Majoritätsträger. Überprüfen Sie daraufhin ihre Vorgehensweise in Teilaufgabe c).